

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：李蕙瑩 研究員
電話：02-2737-7150
傳真：02-2737-7607
電子郵件：vvlee@nstc.gov.tw

受文者：行政院原子能委員會核能研究所

發文日期：中華民國111年9月28日
發文字號：科會科字第1110060546號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (111U0P010072_111D2028478-01.pdf)

主旨：國科會與美國國家科學基金會(NSF)共同徵求2023-2026年「臺美先進半導體晶片設計與製作合作研究計畫(ACED Fab Program)」，自即日起至2023年1月17日受理申請，請於截止日前完成線上申請並造冊函送本會，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、為鼓勵臺美雙方學者在半導體及微電子領域之學術合作，並培育晶片設計實作人才，本會與美方(NSF)依2022年8月22日簽署合作備忘錄及執行協議，共同徵求旨揭計畫，申請方式詳如附件公告徵件說明及本會網頁「計畫徵求專區」。
- 二、本申請案須由臺灣與美國雙方計畫主持人合作研議計畫內容後，分別向本會及美國NSF於申請截止期限內提出申請始得成案。
- 三、為使更多半導體領域之學者專家參與本次共同徵件，本會與美方NSF將於11月15日及23日共同舉辦「臺美先進系統晶



片設計(ACED Fab)學術研討會(線上會議)」，連結臺美半導體領域學者互動交流，歡迎有興趣學者線上參與。

四、本案聯絡人：

(一)相關計畫內容疑問，請洽本會科國處李蕙瑩研究員，電話：(02)2737-7150。

(二)有關系統操作問題，請洽本會資訊系統服務專線，電話：0800-212-058及(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共301單位）

副本：駐美國代表處科技組、駐波士頓辦事處科技組、駐休士頓辦事處科技組、駐舊金山辦事處科技組、駐洛杉磯辦事處科技組、本會工程處、科教國合處(均含附件)



主任委員吳政忠

裝

訂

線

